

“凝聚态物理-北京大学论坛”

2007-24

时间： 2007年11月22日（星期四）下午 15:00 - 16:40

地点： 北京大学物理大楼中 212 教室

报告题目： **Present status and future prospect of wide-gap
semiconductor high-power devices**

报告摘要： **High-power device technique is a key technological factor for wireless communication, which is one of the information network infrastructure in the 21st century, as well as power electronics innovation, which contributes to solving the energy saving problem in the future energy network. In this presentation, the present status and future prospect of wide-gap semiconductor high-power devices, which are based on GaN and SiC materials, are reviewed.**

报告人： **奥村 元 主干研究员**

（日本产业技术综合研究所）

报告人简介： **工学博士（大阪大学），1981年进入日本电子综合研究所工作。现在日本产业技术综合研究所电力电子研究中心（任中心长代理）工作，主干研究员。研究方向主要为宽禁带化合物半导体材料的晶体生长，物性评价及器件应用。**

联系教授： **沈波教授 电话：62767809, bshen@pku.edu.cn**